

Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---	---

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ Mã hồ sơ:	ẢNH 4x6
---	---------

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Bùi Thanh Tùng

2. Ngày tháng năm sinh: 10/6/1981. Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Tứ Kỳ, Thanh Trì, Hà Nội.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 52 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ: Bùi Thanh Tùng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại di động: 0388698119; .

Điện thoại nhà riêng: Điện thoại di động: +84388698119;

Địa chỉ E-mail: tungbt@vnu.edu.vn

7. Quá trình công tác:

– Từ năm 12/2004 đến năm 09/2006: Giảng viên, Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, (Faculty of Technology, Vietnam National University) Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Từ năm 09/2006 đến năm 09/2008: Học viên Cao học, Trường đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, (Ritsumeikan University, Japan) 1 Chome-1-1 Nojihigashi, Kusatsu, Shiga 525-8577, Nhật Bản.

– Từ năm 09/2008 đến năm 09/2011: Nghiên cứu sinh, Trường đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, (Ritsumeikan University, Japan) 1 Chome-1-1 Nojihigashi, Kusatsu, Shiga 525-8577, Nhật Bản.

– Từ năm 10/2011 đến năm 12/2015: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia, Nhật Bản, (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan) 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8560, Nhật Bản .

– Từ năm 01/2016 đến năm 07/2019: Giảng viên, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, (VNU - University of Engineering and Technology) Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Từ năm 10/2018 đến năm 07/2019: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Điện tử viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, (VNU - University of Engineering and Technology) Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chức vụ: Hiện nay: Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Trung tâm nghiên cứu Điện tử viễn thông/Khoa Điện tử viễn thông; Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; Bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ cơ quan: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 02437547461.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học;: Không có.

8. Đã nghỉ hưu từ tháng năm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):
.....

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 06 năm 2004, ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành: Điện tử

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội/Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

– Được cấp bằng ThS ngày 23 tháng 09 năm 2008, ngành Advanced Science and Engineering (Khoa học và kỹ thuật tiên tiến), chuyên ngành: Vi cơ điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường đại học Ritsumeikan, Nhật Bản/1 Chome-1-1 Nojihigashi, Kusatsu, Shiga 525-8577, Nhật Bản

– Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 09 năm 2011, ngành Khoa học Kỹ thuật (Science and Engineering), chuyên ngành: Vi cơ điện tử

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường đại học Ritsumeikan, Nhật Bản/1 Chome-1-1 Nojihigashi, Kusatsu, Shiga 525-8577, Nhật Bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS thời gian: Không có., ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HDGS cơ sở: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HDGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành Vật lý.

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, nhiều thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực Hệ thống vi cơ điện tử (MicroElectroMechanical System - MEMS). Với kích thước nhỏ, các thiết bị MEMS cho phép chúng tương thích với các hệ thống đặc thù mà những thiết bị có kích thước lớn hơn không thể thực hiện được. Và nhờ khả năng có thể hoạt động ở kích thước nhỏ như vậy, cảm biến MEMS có thể phát hiện những tín hiệu cực nhỏ và bộ chấp hành truyền động MEMS có thể thực thi những nhiệm vụ với độ chính xác rất cao, tạo ra các ứng dụng mới, mang tính đột phá. Ngoài ra, việc tích hợp điện tử tiên tiến với MEMS trên cùng một chip có thể nâng cao hiệu năng hoạt động của hệ thống lên đáng kể bằng việc sử dụng hệ thống phản hồi và điều khiển điện tử. Với những đặc tính vượt trội như vậy, cảm biến MEMS có khả năng ứng dụng trong phạm vi rộng lớn cho các hệ thống thông minh trên một chip, hệ thống phòng thí nghiệm phân tích sinh học-hóa học trên một chip (lab-on-a-chip).

Bên cạnh đó, trong công nghệ chế tạo linh kiện MEMS, quá trình đóng gói (packaging) đóng một vai trò rất quan trọng để có thể đưa các linh kiện MEMS ra ứng dụng thực tế. Chỉ khi có được giải pháp đóng gói thích hợp, các linh kiện MEMS mới có thể phát huy tối đa khả năng làm việc và được chế tạo hàng loạt đưa vào ứng dụng.

Trên cơ sở đó, các hướng nghiên cứu chủ yếu của ứng viên bao gồm:

- Nghiên cứu phát triển các cảm biến vi cơ điện tử (MEMS) và
- Công nghệ đóng gói chip (packaging) tích hợp ba chiều đa nền tảng.

Các định hướng nghiên cứu này phù hợp với nhóm nghiên cứu về Vi cơ điện tử và Vi hệ thống của Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhóm đã thu hút được nhiều cán bộ với nhiều chuyên môn khác nhau đáp ứng được yêu cầu chuyên ngành của định hướng nghiên cứu. □

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 6 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã công bố (số lượng) 13 bài báo KH trong nước, 110 bài báo KH trên tạp chí có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 7 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó có 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất:

Bài báo khoa học tiêu biểu								
TT	Tên bài báo	Tên tác giả	Loại công bố (chi số IF)	Tên tạp chí, kỉ yếu khoa học	Tập	Số	Trang	Năm xuất bản
1	Development of a Passive Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (PC4D) Sensor System for Fluidic Channel Analysis Toward Point-of-Care Applications	Loc Do Quang, Tung Thanh Bui, Bao Anh Hoang, Thanh Pham Van, Chun-Ping Jen, and Trinh Chu Duc	SCIE (KHTN-CN) (IF: 3.076)	IEEE Sensors Journal	19	15	6371-6380	2019
2	A circulatory ionic wind for inertial sensing application	Ngoc Tran Van, Tung Thanh Bui, Thien Xuan Dinh, Canh-Dung Tran, Hoa Thanh Phan, Trinh Chu Duc, and Van Thanh Dau	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.753)	IEEE Electron Device Letters	40	7	1182 - 1185	2019
3	Copper-Filled Through-Silicon Vias with Parylene-HT Liner	Tung Thanh Bui, Naoya Watanabe, Xiaojin Cheng, Fumiki Kato, Katsuya Kikuchi, and Masahiro Aoyagi	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.86)	IEEE Transactions on components, packaging and manufacturing technology	6	4	510-517	2016
4	Bipolar corona discharge based air flow generation with low net charge	Van Thanh Dau, Thien Xuan Dinh, Tibor Terebessy, and Tung Thanh Bui	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.379)	Sensors and Actuators A: Physical	244	6	146-155	2016
5	Sub-Micron-Accuracy Gold-to-Gold Interconnection Flip-Chip Bonding Approach for Electronics–Optics Heterogeneous Integration	Tung Thanh Bui, Motohiro Suzuki, Fumiki Kato, Shunsuke Nemoto, Naoya Watanabe, and Masahiro Aoyagi	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.471)	Japanese Journal of Applied Physics	52	4S	p.04CB08	2013

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

– Giải Nhất, giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2005 (đồng tác giả), cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Giải “Vì lợi ích cộng đồng”, Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2007 (đồng tác giả), cấp Hội khuyến học Việt Nam.

– Young Researcher Award, cấp IEEE CPMT Symposium Japan.

– Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không có.

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã có mong muốn trở thành một giảng viên đại học và đã cố gắng phấn đấu không ngừng. Sau khi tốt nghiệp Đại học tôi đã được Khoa Công nghệ, nay là trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ lại làm giảng viên, từ năm 2004 đến nay.

Trong quá trình công tác, tôi luôn rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng tốt tiêu chuẩn của một giảng viên đại học. Tôi tự nhận thấy mình có đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo, như:

- Luôn giữ gìn và trau dồi phẩm chất đạo đức;
- Có lập trường tư tưởng vững vàng;
- Đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn quốc tế về chuyên môn và nghiệp vụ.
- Không ngừng học tập, phấn đấu trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có sức khỏe tốt, đáp ứng theo yêu cầu nghề nghiệp;
- Có lý lịch bản thân rõ ràng.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 7 năm.

Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2004-2005	0	0	0	0	92	0	92/92
2	2005-2006	0	0	0	0	186	0	186/186
3	2015-2016	0	1	1	0	58	35	58/93
3 thâm niên cuối								
1	2016-2017	0	1	1	5	366	61	319.2/426.6
2	2017-2018	1	1	1	3	282	140	279.4/421.5
3	2018-2019	2	0	3	3	549	187	507.4/736.5

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

– Học ĐH ; Tại nước: từ năm:

– Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (năm 2008) và Luận án Tiến sĩ (năm 2011) tại Nhật Bản năm: 2008/2011

– Thực tập dài hạn (> 2 năm) ; Tại nước: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - AIST), Nhật Bản, từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2015

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

– Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... ; Số bằng: ... ; Năm cấp: ...

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: - Đã tham dự và trình bày báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế: New Zealand (2009); USA (2010, 2013, 2014); Canada (2012); Germany (2013, 2019); Ireland (2014); , Korea (2015); Taiwan (2017, 2018); -

Tham gia trao đổi hợp tác hàn lâm và khoa học quốc tế: Hà Lan, Mỹ, Nhật, Đài Loan, Australia.

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): Học cao học, làm nghiên cứu sinh và postdoc ở nước ngoài (9/2006- 12/2015)

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng):

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từđến.....	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			
1	Trần Minh Cường		✓	✓		12/2015 đến 09/2016	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	2016
2	Nguyễn Đức Giang		✓	✓		05/2016 đến 12/2016	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	2016
3	Nguyễn Ngọc Dũng		✓	✓		06/2017 đến 12/2017	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	2017
4	Trần Hoài Nam		✓	✓		01/2017 đến 12/2018	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	2018
5	Vũ Đức Kiên		✓	✓		01/2018 đến 06/2019	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	2019
6	Hoàng Bảo Anh		✓	✓		01/2018 đến 06/2019	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	2019

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ Không có

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ Không có

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS):

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến vi lỏng phát hiện tế bào sống cho một số ứng dụng y sinh học	Chủ nhiệm	CA.16.3A, Bộ/Sở	08/2016 đến 02/2018	27/08/2018
2	Hệ thống giám sát thông số bệnh nhân từ xa	Chủ nhiệm	CN.05.10, Cơ sở	07/2005 đến 12/2005	29/12/2005

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1. Bài báo khoa học đã công bố:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
1	Strain Sensitive Effect in a Triangular Lattice Photonic Crystal Hole-modified Nanocavity	6	IEEE Sensors Journal	SCIE (KHTN-CN) (IF: 3.076)	13	11/11	2657-2663	2011

2	Investigation of strain sensing effect in modified single-defect photonic crystal nanocavity	6	Optics Express	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.561)	43	19/9	8821-8829	2011
3	Towards highly sensitive strain sensing based on nanostructured materials	7	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Scopus (KHTN-CN)	7	1/4	p. 045012	2011
4	Nanostrain Sensing Based on Piezo-optic Property of a Photonic Crystal Cavity	3	IEEE Transactions on Sensors and Micromachines	Scopus (KHTN-CN)		131/7E	258-263	2011
5	Strain Sensing Effect in Silicon Photonic Crystal Nanocavities	3	Proceedings of the 3rd Int'l Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2011)			/	161-171	2011
6	Fabrication and characterization of silicon micro mirror with CNT hinge	6	Proceedings of The 24th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2011)		1	/	688-691	2011
7	Longitudinal strain sensitive effect in a photonic crystal cavity	6	Procedia Engineering (Elsevier)		3	25/	1357-1360	2011
8	Micromachined NH3 Gas Sensor with ppb-level Sensitivity Based on WO3 Nanoparticles Thinfilm	4	Procedia Engineering (Elsevier)		18	25/	1149-1152	2011
9	Displacement Sensing Based on Two-dimensional Photonic Crystal Nano-rod Defect Cavity	3	Technical Digest of the 28th Sensor Symposium , on Sensors, Micromachine and Applied Systems			/	474-477	2011
10	Integration of SWNT film into MEMS for a micro-thermoelectric device	6	Smart Materials and Structures (IOP publishing)	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.543)	22	19/7	p. 075003	2010
11	Integrated CNTs thin film for MEMS mechanical sensors	6	Microelectronics Journal	SCIE (KHTN-CN) (IF: 1.322)	26	41/12	860-864	2010
12	Measurement of mechanical and thermal properties of co-sputtered WSi thin film for MEMS applications	4	Microsystem Technologies	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.513)	2	16/11	1881-1886	2010
13	Micro/nano-mechanical sensors and actuators based on SOI-MEMS technology	4	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Scopus (KHTN-CN)	63	1/1	p. 013001	2010
14	Combination compress sensing and digital wireless transmission for the MRI signal	3	Proceedings of the IEEE 2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS 2010)		1	/	273-276	2010

15	Theoretical investigation of piezo-optic effect in photonic crystal nanocavity for nanostrain detection	3	Proceedings of the IEEE 2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS 2010)			/	443-446	2010
16	Strain Sensitivity of a Modified Single-Defect Photonic Crystal Nanocavity for Mechanical Sensing	6	Proceedings of the 9th IEEE Conference on Sensors IEEE Sensors, IEEE Sensors 2010		3	/	2585-2588	2010
17	Investigation of strain sensitivity of photonic crystal nanocavity for mechanical sensing	3	Proceedings of the 2010 IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OPT MEMS 2010)		2	/	183-184	2010
18	MEMS process of CNTs thin film and its application	6	The 5th Asia-Pacific conference on Transducers and micro-nano technology (APCOT 2010)			/	223	2010
19	Properties of Sputtered Tungsten Silicide Thin Film Measured by Using MEMS Structures	3	20th Microelectronics Symposium (MES2010)			/	267-270	2010
20	Full analysis and fabrication of a piezoresistive three degree of freedom accelerometer	5	Advances in Natural Sciences			10/6	187-192	2009
21	Three degree of freedom micro accelerometer depends on MEMS technology: Fabrication and application	4	Advances in Natural Sciences			10/6	229-236	2009
22	Evaluation of the piezoresistive effect in single crystalline silicon nanowires	4	Proceedings of the 8th IEEE Conference on Sensors, IEEE Sensors 2009		11	/	41-44	2009
23	Piezoresistive and thermoelectric effects of CNT thin film patterned by EB lithography	6	Proceedings of the 8th IEEE Conference on Sensors, IEEE Sensors 2009		3	/	1048-1051	2009
24	A novel optimization procedure for designing of high-sensitivity piezoresistive accelerometers utilizing MNA method	3	Proceedings of the IEEE 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS 2009)		1	/	44-47	2009
25	Piezoresistive effect in silicon nanowires — A comprehensive analysis based on first-principles calculations	5	Proceedings of the IEEE 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS 2009)		8	/	38-43	2009
26	Characterization of the piezoresistive effect and temperature coefficient of resistance in single crystalline silicon nanowires	5	Proceedings of the IEEE 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS 2009)		10	/	462-466	2009

27	Sensitivity enhancement of piezoresistive micro acceleration sensors with Nanometer Stress Concentration Regions on sensing elements	5	Proceedings of the IEEE 15th International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference (TRANSDUCERS 2009)		7	/	1333-1336	2009
28	Evaluation of Properties of Sputtered Tungsten Silicide Thinfilm for MEMS Applications	7	Technical Digest of The 26th Sensor Symposium on Sensors, Micromachine and Applied Systems			/	182-186	2009
29	Development of a 3-DOF Micro Accelerometer with Wireless Readout	6	IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines	Scopus (KHTN-CN)	3	128/5	235-239	2008
30	Optimum design considerations for a 3-DOF micro accelerometer using nanoscale piezoresistors	6	Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS 2008)		9	/	770-773	2008
31	Design and Simulation of Convective Inertial Sensor	6	Proceedings of the IEEE 2008 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS 2008)		7	/	33-36	2008
32	Three degree of freedom micro accelerometer depend on MEMS technology: Fabrication and application	4	First International Workshop On Nanotechnology And Application (IWNA 2007)			/	89-92	2007
33	Full analysis and fabrication of a piezoresistive three degree of freedom accelerometer	5	First International Workshop On Nanotechnology And Application (IWNA 2007)			/	264-267	2007
34	Development of a Three Degree of Freedom Micro Accelerometer Using MEMS Technology for Wireless Accelerometers Network	6	Technical Digest of The 24th Sensor Symposium on Sensors, Micromachine and Applied Systems			/	387-390	2007
35	Design and Simulation of a Novel 3-DOF MEMS Convective Gyroscope	5	Technical Digest of The 24th Sensor Symposium on Sensors, Micromachine and Applied Systems			/	387-390	2007
36	Application of MEMS pressure sensors in the medical electronic device	5	Proceedings of the Seventh Vietnamese – German Seminar on Physics and Engineering			/	230-234	2004
37	MEMS based multifunctional remote measuring system for medicine	4	Processing of the 9 th Vietnam Conference On Radio & Electronics [REV'04]			/	302-305	2004
38	Ứng dụng cảm biến áp suất MEMS trong thiết bị điện tử y tế	7	Kỷ yếu hội nghị Cơ điện tử toàn quốc, Lần thứ II. Tp. HCM			/	136-140	2004

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
39	Development of a Passive Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (PC4D) Sensor System for Fluidic Channel Analysis Toward Point-of-Care Applications	6	IEEE Sensors Journal	SCIE (KHTN-CN) (IF: 3.076)		19/15	6371-6380	2019
40	A circulatory ionic wind for inertial sensing application	7	IEEE Electron Device Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.753)		40/7	1182 - 1185	2019
41	Symmetry Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor System	3	Vnu Journal of Science: Mathematics - Physics			35/2	0866-8612	2019
42	Study on point-to-ring corona based gyroscope	8	Proceedings of the 32nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2019)			/	672-675	2019
43	Angular Rate Sensing By Circulatory Vortex Flow: Design, Simulation And Experiment	7	Proceedings of the IEEE 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2019)			/	1961-1964	2019
44	Liquid Pumping And Mixing By PZT Synthetic Jet	9	Proceedings of the IEEE 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2019)			/	198-201	2019
45	Nghiên Cứu Phát Triển Một Cảm Biến Vận Tốc Góc Dựa Trên Hiệu Ứng Dòng Xả Corona	6	Hội nghị quốc gia lần thứ 21 về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin			/	259-263	2019
46	A Robust Two-axis Tilt Angle Sensor Based on Air/Liquid Two-phase Dielectric Capacitive Sensing Structure	8	IETE Journal of Research	SCIE (KHTN-CN) (IF: 0.793)		/		2018
47	Estimating the effect of asymmetric electrodes in bipolar discharge ion wind generator	6	IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.135)	3	25/3	900-907	2018

48	Tri-axis convective accelerometer with closed-loop heat source	6	Sensors and Actuators A: Physical	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.379)	1	275/	51-59	2018
49	Dual-pin electrohydrodynamic generator driven by alternating current	5	Experimental Thermal and Fluid Science	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.493)	3	97/	290–295	2018
50	Vortex flow generator utilizing synthetic jets by diaphragm vibration	4	International Journal of Mechanical Sciences	SCI (KHTN-CN) (IF: 4.134)	3	142-143/	432–439	2018
51	A study of angular rate sensing by corona discharge ion wind	5	Sensors and Actuators A: Physical	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.379)	4	277/	169-180	2018
52	Particle precipitation by bipolar corona discharge ion winds	6	Journal of Aerosol Science	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.24)	4	124/10	83-94	2018
53	Fluidic Platform with Embedded Differential Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector for Micro-Object Sensing	6	International Journal of Nanotechnology	SCIE (KHTN-CN) (IF: 0.578)	6	15/1,2,3	24-38	2018
54	Dielectrophoresis Microfluidic Enrichment Platform with Built-In Capacitive Sensor for Rare Tumor Cell Detection	7	BioChip Journal	SCIE (KHTN-CN) (IF: 1.95)	5	12/2	114–122	2018
55	Study on Flow-Focusing Microfluidic Device with External Electric Field for Droplet Generation	6	Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications			/	553-559	2018
56	Experimental Characterization of an Ionically Conductive Fluid Based High Flexibility Strain Sensor	9	Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications		1	/	318-323	2018
57	A study of ion wind generator using parallel arranged electrode configuration for centrifugal flow mixer	5	Proceedings of the 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences			/	305-308	2018

58	Performance Evaluation of A Pzt Actuated Valveless Mixer	7	Proceedings of the 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences			/	682-685	2018
59	Design and Implementation of A Passive C4D Sensor for Microfluidic Channel	5	Proceedings of the 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences			/	734-737	2018
60	Development of an Impedance Spectroscopy Measurement Circuit Board for Protein Detection	6	Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Communications and Electronics (ICCE-2018)			/	84-188	2018
61	Development of a LC Passive Wireless Sensor Utilizing Capacitively Coupled Contactless Detection Structure	6	Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Communications and Electronics (ICCE-2018)			/	243-246	2018
62	A 3D Printed Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor	6	Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Communications and Electronics (ICCE-2018)			/	91-195	2018
63	A closed device to generate vortex flow using PZT	6	Proceedings of the IEEE 13th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS2018)			/	204-207	2018
64	Robust angular rate sensor based on corona discharge ion wind	6	Proceedings of the IEEE 13th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS2018)			/	253-256	2018
65	Study on miniaturized tri-axis heat convection accelerometer with experimental validation	7	Proceedings of the IEEE 13th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS2018)			/	644-647	2018
66	Circular electrodes stepping manipulation platform for A549 cancer cell detection	10	International Journal of Nanotechnology	SCIE (KHTN-CN) (IF: 0.578)		15/11,12	983-997	2018
67	A valveless micropump based on additive fabrication technology	6	International Journal of Nanotechnology	SCIE (KHTN-CN) (IF: 0.578)		15/11,12	1010-1023	2018
68	A compact microfluidic chip with integrated impedance biosensor for protein preconcentration and detection	5	Biomicrofluidics	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.531)	4	11/5	054113-1 - 054113-10	2017

69	Jet flow in a circulatory miniaturized system using ion wind	6	Mechatronics	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.423)	15	47/11	126–133	2017
70	30-GHz High-Frequency Application of Screen Printed Interconnects on an Organic Substrate	6	IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.86)	1	7/9	1506–1515	2017
71	Corona anemometry using dual pin probe	4	Sensors and Actuators A: Physical	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.379)	8	257/4	185-193	2017
72	Circular Electrodes Stepping Manipulation Platform for A549 Cancer Cell Detection	9	Proceedings of the 6th International Workshop on Nanotechnology And Application - IWNA 2017			/	649–652	2017
73	A Valveless Micropump based on Additive Fabrication Technology	6	Proceedings of the 6th International Workshop on Nanotechnology And Application - IWNA 2017			/	627-630	2017
74	Novel Apparatus for Simultaneous Monitoring of Electrocardiogram in Awake Zebrafish	13	Proceedings of the IEEE Sensors 2017 Conference		4	/	1434-1436	2017
75	Computational and experimental study on ion wind scheme based aerosol sampling for biomedical applications	5	Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2017)		2	/	560-563	2017
76	Ionic jet flow in a circulatory miniaturized system	6	Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2017)		3	/	2099-2102	2017
77	A symmetrically arranged electrodes for corona discharge anemometry	6	Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2017)			/	1112-1115	2017
78	Coplanar differential capacitively coupled contactless conductivity detection (cd-c4d) sensor for micro object inside fluidic flow recognition	8	Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2017)		1	/	1124-1127	2017

79	Dielectrophoresis enrichment with built-in capacitive sensor microfluidic platform for tumor rare cell detection	8	Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2017)		1	/	484-487	2017
80	A compact exclusion-enrichment microfluidic chip with integrated impedance biosensor for low concentration protein detection	5	Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS2017)			/	638-641	2017
81	Jet flow generation in a circulatory miniaturized system	3	Sensors and Actuators B: Chemical	SCI (KHTN-CN) (IF: 6.393)	25	223/2	820-826	2016
82	Copper-Filled Through-Silicon Vias with Parylene-HT Liner	6	IEEE Transactions on components, packaging and manufacturing technology	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.86)	5	6/4	510-517	2016
83	Pressure sensor based on bipolar discharge corona configuration	4	Sensors and Actuators A: Physical	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.379)	18	237/1	81-90	2016
84	Bipolar corona discharge based air flow generation with low net charge	4	Sensors and Actuators A: Physical	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.379)	24	244/6	146-155	2016
85	Fabrication and stress analysis of annular-trench-isolated TSV	6	Microelectronics Reliability	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.483)	5	63/8	142-147	2016
86	Corona based air-flow using parallel discharge electrodes	6	Experimental Thermal and Fluid Science	SCIE (KHTN-CN) (IF: 3.204)	27	79/12	52-56	2016
87	Ion Wind Generator Utilizing Bipolar Discharge in Parallel Pin Geometry	4	IEEE Transactions on Plasma Science	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.325)	16	44/12	2979-2987	2016

88	Bipolar corona assisted jet flow for fluidic application	4	Flow Measurement and Instrumentation	SCIE (KHTN-CN) (IF: 1.977)	17	50/8	252-260	2016
89	Piezo-resistive and thermo-resistance effects of highly-aligned CNT based macrostructures	5	RSC Advances	SCIE (KHTN-CN) (IF: 3.049)	10	6/108	106090-106095	2016
90	Developing a leading practical application for 3D IC chip stacking technology - How to progress from fundamental technology to application technology	13	Synthesiology	Scopus (KHTN-CN)	2	9/1	1-15	2016
91	Biological microparticles detection based on differential capacitive sensing and dielectrophoresis manipulation	5	Proceedings of the IEEE 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)		6	/	297-301	2016
92	Tilt sensor based on three electrodes dielectric liquid capacitive sensor	7	Proceedings of the 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)		9	/	172-175	2016
93	Integration of a microfluidic chip with multiplexed optical fluorescence detector through anisotropic etching of Si using Tetramethylammonium hydroxide (TMAH)	5	Proceedings of the IEEE 6th Electronic System-Integration Technology Conference (ESTC2016)			/	6pp	2016
94	Low Residual Stress in Si Substrate of Annular-Trench-Isolated TSV	5	Proceedings of the IEEE 66th Electronic Components and Technology Conference (ECTC2016)		1	/	1611-1616	2016
95	A Prospective Low-k Insulator for Via-Last through-Silicon-Vias (TSVs) in 3D Integration	6	Proceedings of the IEEE 66th Electronic Components and Technology Conference (ECTC2016)			/	2182-2187	2016
96	Two-axis tilt angle detection based on dielectric liquid capacitive sensor	7	Proceedings of the 2016 IEEE Sensors Conference		3	/	907-909	2016
97	Jet flow focusing by corona discharge for fluidic application	5	Proceedings of the 2016 IEEE Sensors Conference			/	826-828	2016
98	Absolute pressure sensing with bipolar corona discharge: Design, simulation and experimental validation	5	Proceedings of the 2016 IEEE 29th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2016)		4	/	820-823	2016

99	A method enabling height-control of chips for edge-emitting laser stacking	6	Japanese Journal of Applied Physics	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.471)		54/4S	p. 04DB02	2015
100	Twice-etched silicon approach for via-last through-silicon-via with a Parylene-HT liner	4	Proceedings of the IEEE 2015 International 3D Systems Integration Conference (3DIC 2015)		5	/	160-163	2015
101	Study on the PZT diaphragm actuated multiple jet flow in a circulatory miniaturized system	4	Proceedings of the 2015 IEEE Sensors Conference		6	/	4pp	2015
102	Differential capacitively coupled contactless conductivity detection (DC4D) sensor for detection of object in microfluidic channel	6	Proceedings of the 2015 IEEE Sensors Conference		15	/	4pp	2015
103	Micro fluidic platform for living cell detection	6	Proceedings of the 5th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA 2015)			/	223-226	2015
104	15- μ m-pitch Cu/Au interconnections relied on self-aligned low-temperature thermosonic flip-chip bonding technique for advanced chip stacking applications	6	Japanese Journal of Applied Physics	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.471)	6	53/4S	p. 04EB04	2014
105	Silver screen printed transmission lines- analyzing the influence of substrate roughness on the RF performance up to 30 GHz	7	Proceedings of the IEEE 16th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC), 2014			/	22-26	2014
106	Fabrication and electrical characterization of Parylene-HT liner bottom-up copper filled through silicon via (TSV)	6	Proceedings of the 2014 IEEE CPMT Symposium Japan (ICSJ)		8	/	154-157	2014
107	Investigation of low-temperature deposition high-uniformity coverage Parylene-HT as a dielectric layer for 3D interconnection	6	Proceedings of the IEEE 64th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 2014		17	/	1926-1931	2014
108	Flip-chip bonding alignment accuracy enhancement using self-aligned interconnection elements to realize low-temperature construction of ultrafine-pitch copper bump interconnections	5	Proceedings of the IEEE 64th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 2014		6	/	62-67	2014
109	Capacitive sensor based on PCB technology for air bubble inside fluidic flow detection	6	Proceedings of the 2014 IEEE SENSORS		7	/	237-240	2014

110	A method enables height-control of bonding chip for edge-emitting laser stacking	6	Extended abstract of The 2014 International Conference on Solid State Devices and Materials,			/	510-511	2014
111	Copper filled TSV formation with Parylene-HT insulator for low-temperature compatible 3D integration	6	Proceedings of the IEEE 2014 International conference on 3D Systems Integration Conference (3DIC 2014)		2	/	4pp	2014
112	High-precision integration approach based on alignment maintaining flip-chip bonding using cone shaped bump and truncated pyramid pad	5	Proceedings of the IEEE 2014 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN)			/	105-106	2014
113	Sub-Micron-Accuracy Gold-to-Gold Interconnection Flip-Chip Bonding Approach for Electronics–Optics Heterogeneous Integration	6	Japanese Journal of Applied Physics	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.471)	12	52/4S	p.04CB08	2013
114	A micromirror with CNTs hinge fabricated by the integration of CNTs film into a MEMS actuator	7	Journal of Micromechanics and Microengineering	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.141)	12	23/7	p. 075024	2013
115	Investigation of a microchannel-based cooling interposer for high-performance memory-on-logic 3DIC design	8	Proceedings of the 15th IEEE Electronics Packaging Technology Conference (EPTC 2013), 2013			/	358-362	2013
116	Modified thermosonic flip-chip bonding based on electroplated Cu microbumps and concave pads for high-precision low-temperature assembly applications	7	Proceedings of the IEEE 63rd Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 2013		6	/	425-430	2013
117	Investigation of the applicability of parylene-HT as a dielectric layer for interconnections in 3D integration system	6	Proceedings of the International Symposium on Frontiers of Materials Science (ISFMS)			/	169-170	2013
118	15- μ m-pitch Cu/Au Interconnections Relied on Self-aligned Low-temperature Thermosonic Flip-chip Bonding Technique for Advanced Chip Stacking Applications	6	Extended Abstracts of the 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2013)			/	986-987	2013
119	Study of Copper Diffusion into Parylene-HT Dielectric Thinfilm using Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry (D-SIMS)	6	International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2013 (MSST2013)			/	PA13.1-4	2013

120	Heterogeneous Integration Approach based on Flop-chip Bonding and Misalignment Self-correction Elements for Electronics-Optics Integration Applications	5	Vietnam Journal of Mechanics			34/4	289-297	2012
121	Integration of CNTs Thinfilm for Sensing and Actuating Micro Structures	4	Vietnam Journal of Mechanics			34/4	299-309	2012
122	High-precision heterogeneous integration based on flip-chip bonding using misalignment self-correction elements	6	2012 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN)		4	/		2012
123	Sub-micron-accuracy Gold to Gold Interconnection Flip-Chip Bonding Approach for Electronics-Optics Heterogeneous Integration	7	Extended Abstracts of the 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012)			/	1174-1175	2012

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

Chú thích: (*) gồm SCI, SCIE, ISI, Scopus (KHTN-CN); SSCI, A&HCI, ISI và Scopus (KHXXH-NV); SCI nằm trong SCIE; SCIE nằm trong ISI; SSCI và A&HCI nằm trong ISI.

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ Không có.

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Số tác giả
1	Through electrode and manufacturing method of through electrode and semiconductor device and manufacturing method of semiconductor device, JP 6519785 B2, 29/5/2019.	Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO)	29/05/2019	6
2	Through electrode, manufacturing method thereof, and semiconductor device and manufacturing method thereof, US 9984956 B2, 29/5/2018	Cục Sáng chế và Nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO)	29/05/2018	5
3	Semiconductor device, interposer, and manufacturing method of interposer, JP 6430153 B2, 28/11/2018	Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO)	08/11/2018	8
4	Method of manufacturing semiconductor device and semiconductor device manufacturing apparatus, US 9627347 B2, 18/04/2017	Cục Sáng chế và Nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO)	18/04/2017	7
5	Through electrode, manufacturing method thereof, and semiconductor device and manufacturing method thereof, US 9818645 B2, 14/11/2017	Cục Sáng chế và Nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO)	14/11/2017	5
6	Method of manufacturing a semiconductor device, and semiconductor manufacturing device, JP 5967678 B2, 10/8/2016	Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO)	10/08/2016	7
7	Hệ thống giám sát bệnh nhân từ xa, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1018	Cục sở hữu trí tuệ	26/11/2012	6

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...):

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
1	Đồng tác giả, giải Nhất - giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2005	Bộ Giáo dục và Đào tạo	8254/QĐ/BGD&ĐT-VP, 22/12/2004	2
2	Đồng tác giả, giải “Vi lợi ích cộng đồng”, giải thưởng Nhân tài đất Việt 2007	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT	000000, 0/0/0	10

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
3	Young Researcher Award	IEEE Component, Packaging and Manufacturing Technology Society, IEEE CPMT Symposium Japan	000000, 4/11/2014	1

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học:

TT	Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò: Chủ trì/Tham gia	Tên cơ sở giáo dục đại học
1	Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính	Tham gia	Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2	Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử	Tham gia	Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
3	Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Robot	Tham gia	Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín:

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS:

- Giờ chuẩn giảng dạy:

- Công trình khoa học đã công bố:

- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Hướng dẫn NCS, ThS:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày..... tháng..... năm 201...

Người đăng ký

(Ghi rõ họ tên, ký tên)

D. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC

– Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai.

– Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.

(Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).

..., ngày.....tháng.....năm 201...

Thủ trưởng cơ quan

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)